© EPODOC / EPO

'PN - JP63080454 A 19880411

PD - 1988-04-11

PR - JP19860224097 19860922

OPD - 1986-09-22

TI - VACUUM PROCESSING CHAMBER DEVICE

IN - TATEMICHI JUNICHI

PA - NISSIN ELECTRIC CO LTD

IC - H01J37/317; H01L21/265; H01L21/302

© WPI / DERWENT

 Vacuum process chamber for ion-beam mfr. of semiconductor device - has workpiece feed mechanism in which feed screw and spline shaft are driven by respective drive sources. NoAbstract Dwg 1/5

PR - JP19860224097 19860922

PN - JP63080454 A 19880411 DW198820 003pp

PA - (NDEN) NISSHIN ELECTRICAL KK

IC - H01J37/31;H01L21/26

OPD - 1986-09-22

AN - 1988-137486 [20]

@ PAJ / JPO

PN - JP63080454 A 19880411

PD - 1988-04-11

AP - JP19860224097 19860922

IN - TATEMICHI JUNICHI

PA - NISSIN ELECTRIC CO LTD

TI - VACUUM PROCESSING CHAMBER DEVICE

- PURPOSE:To enable uniform irradiation of even a large material, in simplified composition, by moving a material holder freely in the X and y directions by means of driving sources so as to perform mechanical scanning and irradiating a material in the material holder with ion beams from an ion irradiation device.
 - CONSTITUTION: When a screw axis 6a is rotated/driven by the first driving source 17, the first moving member 7 gearing with the axis 16a is moved up and down (in the Y direction) along a Y guide axis 6. when a spline axis 19 is rotated/driven by the second driving source 23, a screw axis 18a is rotated through bevel gears 24a and 22 so that the second moving member 9 is moved in the lateral (X)

none

direction. Use of this axis 19 enables rotational transfer to the axis 18a independently of up-and-down positions of the moving member 7. Therefore a material holder 8 can be moved freely in the X and Y directions by means of the driving sources 17 and 23. Alternate long and short dash lines indicate stroke ends for a normal operation of the holder. Thus a material 14 in the holder 8 is irradiated with ion beams 5 from an ion irradiation device while the holder 8 is moved in the X and Y directions, that is, X and Y mechanical scanning is performed.

- H01J37/317 ;H01L21/265 ;H01L21/302

none none none

⑩ 日本 国特許庁(JP)

① 特許出願公開

¹⁹ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-80454

(1) Int Cl.

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988) 4月11日

H 01 J H 01 L 37/317 21/302 B-7129-5C D-7738-5F

未請求 発明の数 1 審査請求 (全5頁)

49発明の名称

真空処理室装置

の特 頭 昭61-224097

9出 頣 昭61(1986)9月22日

明 立·道 ②発 者

京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 日新電機株式会社

内

日新電機株式会社 砂出 頭

京都府京都市右京区梅津高畝町47番地

理 沙代 弁理士 宮井 暎 夫

1. 発明の名称

真空処理室装置

2. 特許研求の範囲

直空引きされる処理室と、この処理室内に一定 方向に進退自在に設置した第1移動体と、前記処 理室内に設けられて前記処理室外の第1駆動源に 連結され前記第1移動体を進退させる第1送りね じ機構と、前記第1移動体にこの第1移動体の進 退方向と直交する方向に進退自在に設置され材料 ホルダを有する第2移動体と、前記第1移動体に 設けられて前記第1移動体を進退させる第2送り ねじ機構と、前記第1送りねじ機構のねじ軸と平 行に設けられて前記真空室外の第2駆動源で回転 翌動されるスプライン軸と、前記第1移動体に設 けられて前記スプライン軸から回転伝達される回 転節材を有しこの回転部材の回転を前記第2送り ねじ機構のねじ軸に伝達する凹転伝達機構とを値 えた真空処理室装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、イオン照射装置等を用いてイオン 注入やエッチング、薄膜形成等を行なう場合に用 いる真空処理室装置に関するものである。

〔従来の技術〕

従来からイオン照射装置を用いてイオンピーム をウェハ等の材料に照射することにより各種の処 理が行われている。この処理の例としては、イオ ン注入やIVD(イオンベーパーデポジション) 法による薄膜形成、イオンボンバード洗浄などが ある。

このような各種の処理は、いずれも真空中で行 う必要があり、またイオンピームの均一照射のた めに、材料に対してイオンピームのスキャンの必 ሧがある。

このスキャンの方法として、イオンピームの照 射角度を変える静電スキャンと、材料側を移動さ せるメカニカルスキャンとが採用されている。メ カニカルスキャンの機構としては、材料ホルダを 回転および進退させる構造のものが一般的である。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前記師電スキャンは、大面積の材料に対して照射する場合に、材料に対する照射角度が大きく変動するため、均一な照射が行なえないという問題がある。

また、前記回転並進形式のメカニカルスキャンの場合、円間執路と直接執路の組合せとなるため、均一照射を行なうためには回転と並進の速度バランス等を図るにつき、複雑な制御が必要になるという問題点がある。

均一照射と制御の簡易のためには、面交する2 方向のメカニカルスキャン、いわゆるXYメカニカルスキャンが望ましい。しかし、一般の大気ので使用されるX-Yテーブルを移動させるモータがでいた上段の可動テーブルを移動させるものででであり、真空の処理室に使用するも、現在のででも一タをドライブといる。できる、超高真空中でモータをドライブといる。そのため、一名処理には超高真空を必要とする。そのため、一名処理には超高真空を必要とする。そのため、面

に伝達する回転伝達機構とを備えたものである。

この発明の構成によると、材料ホルダを育し第 1 移動体にその進退方向と直交方向に移動自在に 设けた第2移動体を、第1移動体の駆動用の送り ねじ機構と平行なスプライン軸を介して駆動する ようにしており、そのため両移動体の駆動源を処 理室の外部に設置しながら、材料ホルダの直交す る2方向の移動が行なえる。そのため、処理室が 超高真空であっても、通常の駆動源を用いていわ ゆるX-Yメカニカルスキャンが行なえる。この ように、直交する2方向のX-Yメカニカルスキ ャンを行なうので、従来の回転並進型のメカニカ ルスキャンに比べて簡単な制御でイオンピーム等 の均一照射が行なえる。また、XーYメカニカル スキャンを行なうので、辞電スキャンの場合と異 なり、材料が大面積の場合であっても、材料に対 する照射方向が常に変わらず、均一照射が行なえ

(実施例)

股のX-Yテーブルをこの種の真空処理窓に用いることができない。

この発明の目的は、大面積の材料であっても、 均一なイオンビーム等の照射を行なえ、かつ物質 が簡単な真空処理室装置を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

この発明の一実施例を第1図ないし第5図に基づいて説明する。処理室1はその下方に設けた材料交換用の予備室2と関口3で連通しており、各々別の吸引装置(図示せず)で真空引きされる。処理室1の後壁にはファラデーカップ4が設けてあり、ファラデーカップ4に向けてイオンピーム5を照射するイオン照射装置(図示せず)が、処理室1の前壁に設けてある。

処理室1内に立設した2本のYガイド軸6に第1移動体7がボールブッシュ(図示せず)を介して上下(Y方向)に進退自在に設置してある。材料ホルダ8を有する第2移動体9は、第1移動体7にYガイド軸6と直交して設けたXガイド軸10に、ボールブッシュ(図示せず)を介して進退自在に設置してある。Yガイド軸6は上下端を固定板11に固定してある。Xガイド軸10は支持部材12、13で第1移動体7に取付けられている。材料ホルダ8は、ウェハ等の材料14を前面に保持するものである。第2移動体9には予備室2の関口3を閉じるゲート弁15が、材料ホルダ8の

上方に位置して設けてある.

第1移動体 7 は、ボールねじ式の第1送りねじ 機構 1 6 のねじ軸 1 6 a にボールねじのナット部 1 6 b で螺合しており、ねじ軸 1 6 a は処理室 1 の上壁 1 a 上の第1駆動源 1 7 と連結されている。 ねじ軸 1 6 a は前記固定板 1 1 に上下機が支軸されている。第1駆動源 1 7 は、ブレーキ付ステッピングモータ等からなる。

第2移動体 9 は、ボールねじ式の第2送りねじ 協構 1 8 のねじ軸 1 8 a にボールねじのナット部 1 8 b で螺合し、ねじ軸 1 8 a はスプライン軸 19 から回転伝達機構 2 0 を介して回転伝達される。 ねじ軸 1 8 a は支持部材 1 3 と協車支持部材 2 1 とで両端が支持され、一端に 傘備車 2 2 が取付けられている。スプライン軸 1 9 は、上下端が固定版 1 1 に回転自在に支持されて第1送りねじ機構 1 6 のねじ軸 1 6 a と平行に設けられ、処理室 1 の上壁 1 a 上の第2 駆動源 2 3 と連結されている。 第2 駆動源 2 3 は、 直波サーボモータ等からなる。スプライン軸 1 9 は、 第1移動体 7 に回転自在に

ている。各カップリング30a. 30b. 31a. 31bはセンタずれが生じても連結可能なものである。このように連結したのは次の理由による。すなわち、機械加工の問題において、処理室1に直接に一対のカイド軸6とねじ軸16aとスプライン軸19との4本の軸中心を構度を出して取付けるのは難しい。そのため、上下一対の固定板11(第1図)に各軸6. 16a. 19の軸中心ビッチを精度良く出して支持しておき、処理室1の内外2箇所でカップリング30a. 30b. 31a. 31bにより各駆動源17. 23と連結している。

第4図は、材料ホルダ8と第2移動体9との通 結部構造を示す。材料ホルダ8は第2移動体9の 位置決めピン32に嵌入する孔33と一対のポル ト挿通孔(関示せず)を有し、位置決めピン32 の両側で固定ねじ34(第1図)により第2移動 体9に固定される。

この構成の動作を説明する。第1駆動源17で ねじ軸16aを回転駆動すると、これに螺合して いる第1移動体7がYガイド軸6に沿って上下動 支持された回転部材24とでポールスプラインを形成しており、回転部材24に前記傘歯車22と 暗合う傘歯車24aが一体に形成してある。これら傘歯車22、24aと回転部材24とで回転伝達毀積20が構成される。

第2図はスプライン軸19の断面と回転部材24を示す。回転部材24は、スプライン軸19の突 条19aの両面に接する球体25が保持してあり、 スプライン軸19に軸方向移動自在に係合する。

第3図は、第1送りねじ機様16のおじ軸16a とスプライン軸19の真空シールおよび連結構造 を示す。ねじ軸16aが処理室1の上壁1aを質 通する部分は、フッ素相脂コーティングを行なっ た2つのOリング27を有するシール装置28が 設けてある。スプライン軸19は高速回転するた め、その貫通部には磁性流体を用いたシール装置 29を用いている。ねじ軸16とスプライン軸19 は、各々第1駆動調17および第2駆動源23の 出力軸に対し、2つのカップリング30a、30b。 31a、31bを処理室1の内外で用いて連結し

材料14の交換を行なうときは、材料ホルダ8 が予備室2に入るまで第1駆動源17により第1 移動体7を下降させ、ゲート弁15で開口3を閉 じる(第5図)。この状態で予備室2の取出口 (図示せず)を開いて材料交換を行なう。

このように、イオン照射により材料14の処理 を行なうが、第1移動体7の駆動用の第1送りね じ機構16と平行なスプライン動19で第2移動 体 9 に駆動伝達するようにしたため、第 1 移動体 7と第2移動体9の駆動調17,23を共に処理 室1の外部に設置することができる。そのため、 処理室1が超高真空室であっても、駆動源17. 23に通常のモータ等を用いて X-Yメカニカル スキャンが行なえる。このように、直交する2方 向のX-Yメカニカルスキャンを行なうので、従 来の回転並進型のメカニカルスキャンに比べて、 簡単な制御でイオンピーム5の均一照射が行なえ る。また、X-Yメカニカルスキャンを行なうの で、静電スキャンでは不可能な大面積の材料14 の場合であっても、材料14に対するイオンビー ム5の照射方向を常に垂直に保つことができ、均 一照射が行なえる。

また、この実施例では、第2移動体9にゲート 弁15を設け、処理室1の底に予備室2を設けた ので、材料ホルダ8のYスキャンのための構成を

を処理室の外部に設置しながら、材料ホルダの直 交する 2 方向の移動が行なえる。そのため、処理 窓が超高直空であっても、通常の駆動源を用いていわゆる X - Y メカニカルスキャンが行なえる。 このように、直交する 2 方向の X - Y メカニカル スキャンを行なうので、従来の回転並進型のメカニカルスキャンに比べて簡単な制御でイオメカニ ム等の均一照射が行なえる。また、 X - Y メカニカルスキャンを行なうので、前電スキャンの場合 カルスキャンを行なうので、前電スキャンの場合 と異なり、材料が大面積の場合であっても、材料 に対する照射方向が常に変わらず、均一照射が行なえるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例の段断正面図、第 2図はそのスプライン軸部分の断面図、第3図は同じくその処理室上部の拡大段断正面図、第4図は同じくその材料ホルダ取付部の拡大側面図、第 5図は同じくその材料ホルダ取付部の拡大側面図、第

1…処理室、2…予備室、5…イオンピーム、6…Yガイド軸、7…第1移動体、8…材料ホル

ゲート弁15の関閉手段として兼用できる。そのため、ゲート弁15の関閉駆動機構を別に投けることが不要であり、構造が簡単となる。さらに、この実施例では、第2移動体9に材料ホルタ8を吊持するようにしたので、第2移動体9や第1移動体7等の機構部分にイオンピーム5が当ることがなく、これらの機構部分をイオンピーム5の照射によって損傷することがない。

なお、前記実施例では、第1移動体でおよび第 2移動体9の移動方向を垂直面内にとったが、水 平面内にとり、上方または下方からイオンピーム 5 等の照射を行なうようにしてもよい。また、こ の真空処理室装置は、イオンピーム 5 以外の手段 で処理する場合にも適用することができる。

(発明の効果)

この発明の真空処理室装置は、材料ホルダを有 し第1移動体にその進退方向と直交方向に移動自 在に設けた第2移動体を、第1移動体の駆動用の 送りねじ機構と平行なスプライン軸を介して駆動 するようにしており、そのため両移動体の駆動源

ダ、9 … 第 2 移動体、1 0 … X ガイド軸、1 4 … 材料、1 6 … 第 1 送りねじ機構、1 7 … 第 1 駆動 源、1 8 … 第 2 送りねじ機構、1 9 … スプライン 軸、2 0 … 回転伝連機構、2 4 … 回転部材

> 特許出職人 日新電機株式会社 元(1) 代 理 人 弁理士 官井疾夫(2) ED855

特開昭63-80454 (5)



